



www.icm-semi.com

**CM1003-CFS**

**单节可充电锂电池保护 IC**

CM1003-CFS 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

## ■ 功能特点

### 1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.425 V	精度 ±25 mV
• 过充解除电压	4.225 V	精度 ±45 mV
• 过放电保护电压	2.300 V	精度 ±50 mV
• 放电解除电压	2.500 V	精度 ±100 mV
• 放电过流保护电压	0.250 V	精度 ±10 mV
• 短路保护电压	0.500 V	精度 ±60 mV
• 充电过流保护电压	-0.100 V	精度 ±10 mV

### 2) 内部检测延迟时间

• 过充电保护延时	1.0 s	精度 ±30%
• 过放电保护延时	128 ms	精度 ±30%
• 放电过流保护延时	16 ms	精度 ±30%
• 充电过流保护延时	16 ms	精度 ±30%

### 3) 充电器检测及负载检测功能

### 4) 向 0V 电池充电功能

允许

### 5) 休眠功能

无

### 6) 放电过流状态的解除条件

断开负载

### 7) 放电过流状态的解除电压

$V_{RIOV}$

### 8) 低电流消耗

• 工作时	1.5 $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ C$ )
• 过放电时	0.5 $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ C$ )

### 9) RoHS、无铅、无卤素

## ■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

## ■ 封装

- SOT23-6

## ■ 系统功能框图

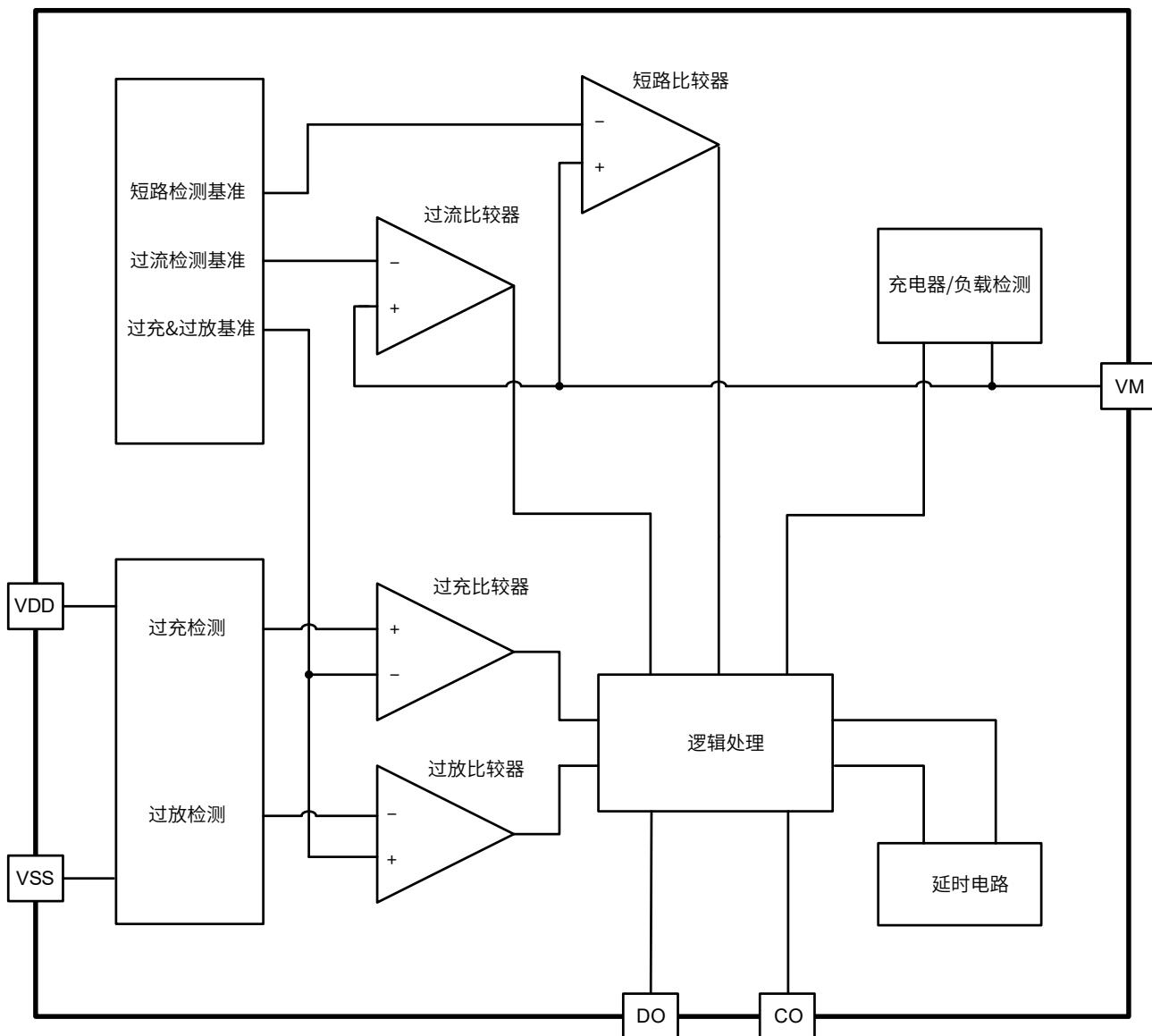
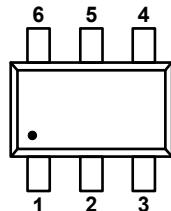


图 1

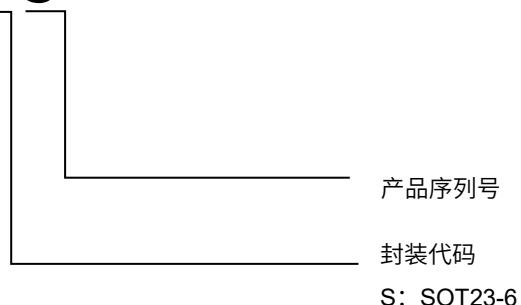
**■ 引脚排列图****SOT23-6****图 2**

引脚号	符号	描述
1	DO	放电 MOSFET 控制端子
2	VM	充放电电流检测端子，与充电器或负载的负极连接
3	CO	充电 MOSFET 控制端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
6	VSS	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连

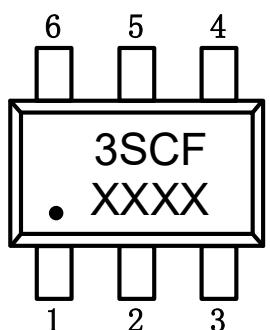
**表 1**

■ 命名规则

CM1003-CFS



■ 印字说明



第一行：“3SCF” 固定打印  
第二行：生产批次

图 3

## ■ 产品列表

### 1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 $V_{OC}$	过充电 解除电压 $V_{OCR}$	过放电 保护电压 $V_{OD}$	过放电 解除电压 $V_{ODR}$	放电过流 保护电压 $V_{EC}$	短路 保护电压 $V_{SHORT}$	充电过流 保护电压 $V_{CHA}$
CM1003-CFS	4.425 V	4.225 V	2.300 V	2.500 V	0.250 V	0.500 V	-0.100 V

表 2

### 2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池充电 功能	放电过流状态解 除条件	放电过流状态解 除电压	过充自恢复功能	休眠功能
CM1003-CFS	允许	断开负载	$V_{RIOV}$	有	无

表 3

### 3. 延迟时间代码

过充电保护延时 $T_{OC}$	过放电保护延时 $T_{OD}$	放电过流延时 $T_{EC}$	充电过流延时 $T_{CHA}$	短路延时 $T_{SHORT}$
1000 ms	128 ms	16 ms	16 ms	280 $\mu$ s

表 4

**■ 绝对最大额定值**(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^{\circ}\text{C}$ )

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	$V_{DD}$	$V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+8.0$	V
VM 输入端子电压	$V_{VM}$	$V_{DD}-28 \sim V_{DD}+0.3$	V
CO 输出端子电压	$V_{CO}$	$V_{VM}-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
DO 输出端子电压	$V_{DO}$	$V_{SS}-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
工作温度范围	$T_{OPR}$	-40 ~ +85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	$T_{STG}$	-55 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。





## ■ 功能描述

### 1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压 ( $V_{OD}$ ) 以上并在过充电保护电压 ( $V_{OC}$ ) 以下，且VM端子电压在充电过流保护电压 ( $V_{CHA}$ ) 以上并在放电过流保护电压 ( $V_{EC}$ ) 以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

### 2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压 ( $V_{OC}$ )，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间 ( $T_{OC}$ ) 时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

1)  $VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充解除电压 ( $V_{OCR}$ ) 以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

2) 移开充电器并连接负载 ( $VM > V_{EC}$ )，当电池电压降低到过充电保护电压 ( $V_{OC}$ ) 以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

### 3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压 ( $V_{OD}$ ) 以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间 ( $T_{OD}$ ) 时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VDD端子-VM端子间的电压差降低到1.0V(典型值)以下，消耗电流将减少至过放时的消耗电流 ( $I_{OPED}$ )，在过放电状态下，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压 ( $V_{OD}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ (典型值)  $< VM < 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放解除电压 ( $V_{ODR}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放解除电压 ( $V_{ODR}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

### 4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压( $V_{EC}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间 ( $T_{EC}$ )，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压( $V_{SHORT}$ )，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间 ( $T_{SHORT}$ )，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件 “断开负载” 及放电过流状态的解除电压 “ $V_{RIOV}$ ”。

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间通过RVMS电阻来连接。在连接负载期间，VM端子由于负载连接

而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到VRIOV以下时，即可解除放电过流状态。

## 5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ $V_{CHA}$ ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ $T_{CHA}$ ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

注意：充电过电流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由 $R_{VMC}$ 或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

## 6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“允许向0V电池充电的充电器电压（ $V_{OCHA}$ ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ $V_{th}$ ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ $V_{op}$ ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

■ 典型应用原理图

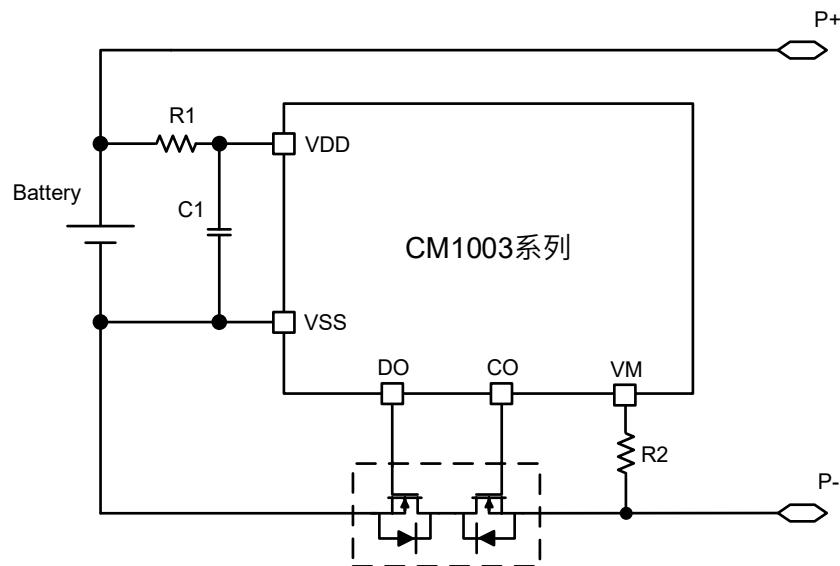


图 4

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	330	100 ~ 1000	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 1.0	μF
R2	1	1 ~ 3	kΩ

表 8

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

## ■ 时序图

### 1. 过充电保护、充电过流保护

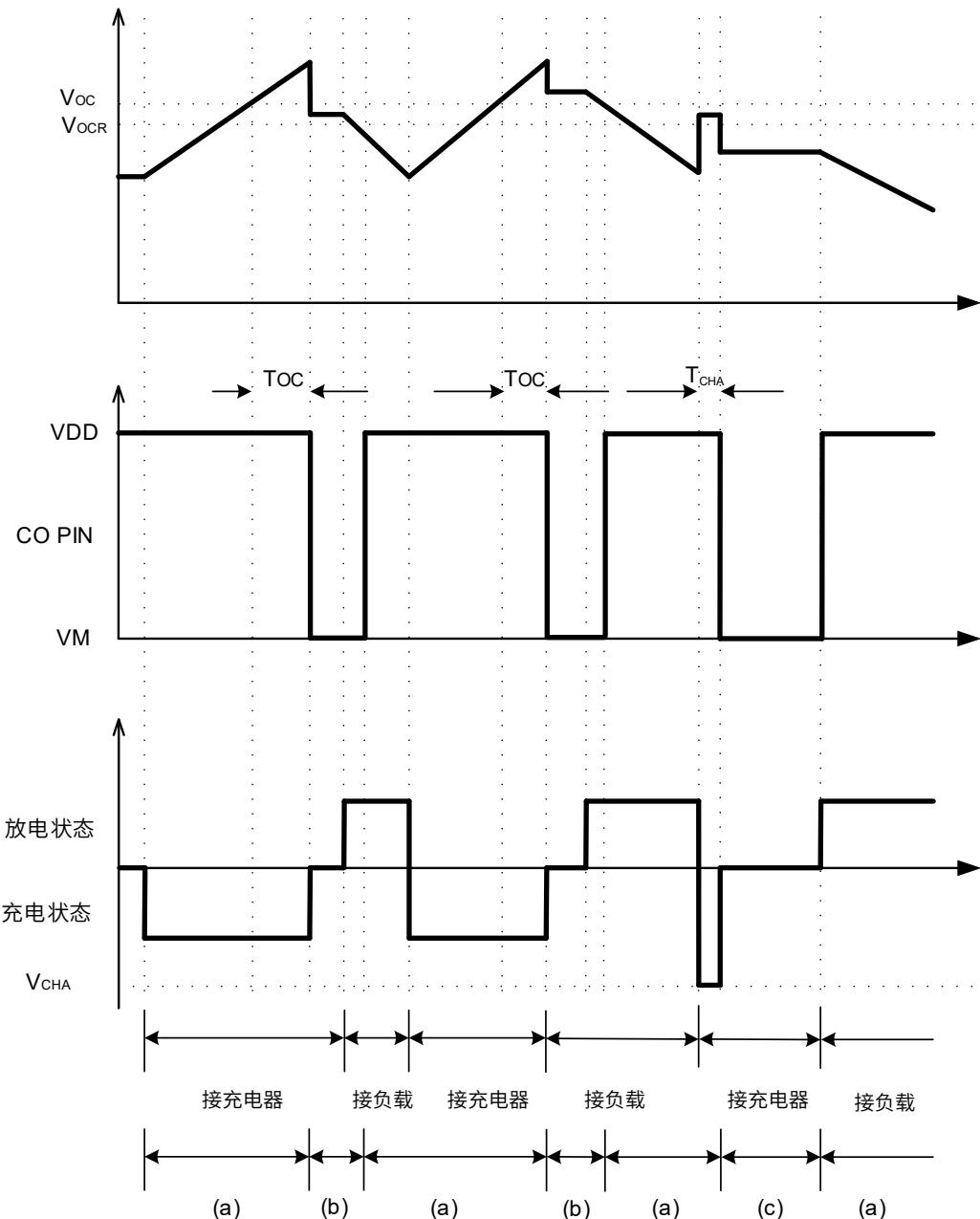


图 5

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

## 2. 过放电保护、放电过流保护

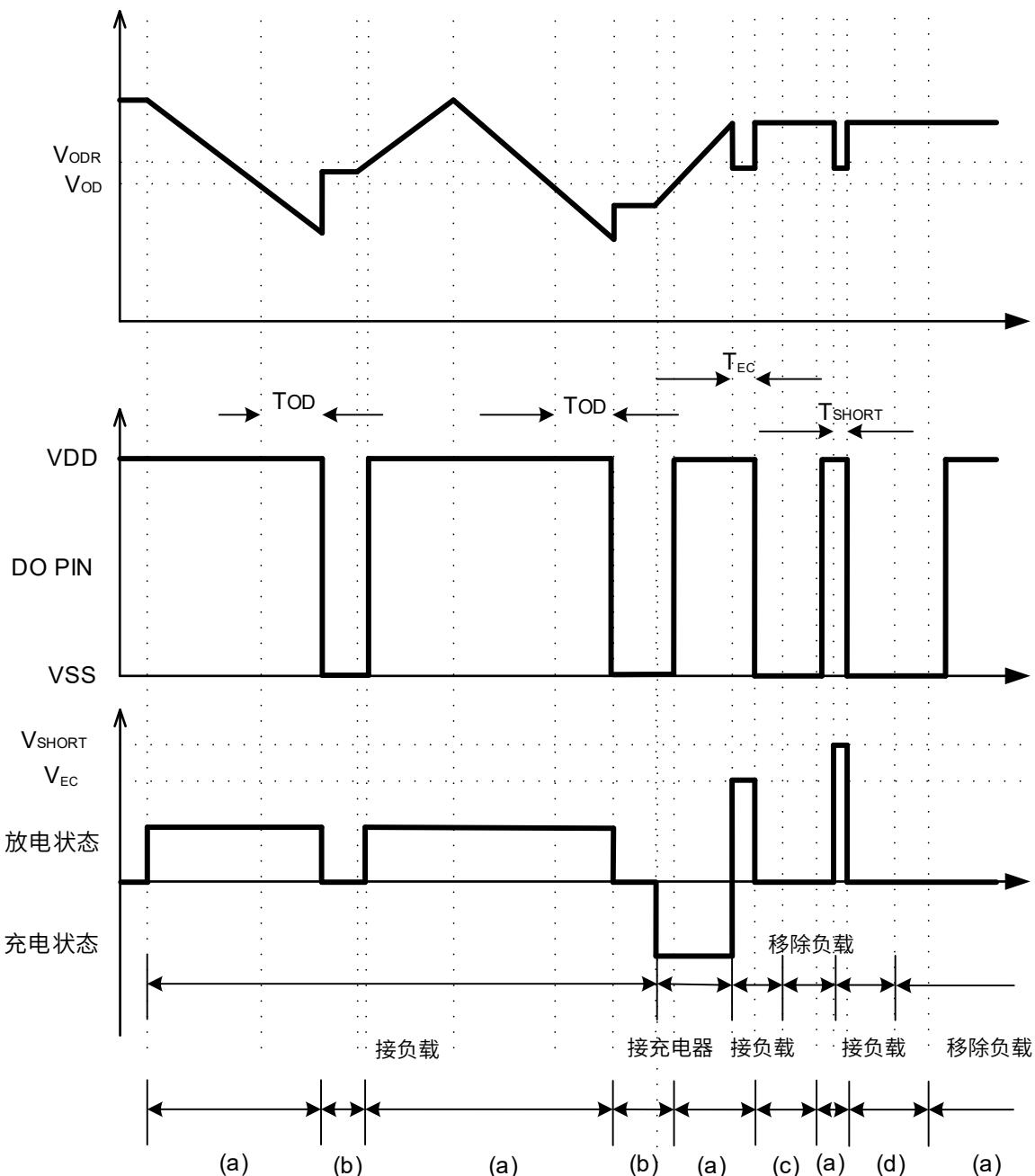


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

## ■ 测试电路

### 1. 过充电保护电压、过充解除电压（测试电路 1）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V1缓慢提升至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的V1的电压即为过充电保护电压 ( $V_{OCP}$ )。之后，设置V2=0.01V，将V1缓慢下降至 $V_{CO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的V1的电压即为过充解除电压 ( $V_{OCR}$ )。

### 2. 过放电保护电压、过放解除电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V1缓慢降低至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的V1的电压即为过放电保护电压( $V_{ODP}$ )。之后，设置V2=0.01V，将V1缓慢提升至 $V_{DO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的V1的电压即为过放解除电压 ( $V_{ODR}$ )。

### 3. 放电过电流保护电压、放电过电流解除电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2提升，直至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止，此时的V2电压即为放电过电流检测电压 ( $V_{EC}$ )。

在放电过电流状态下，设置V2=3.5V，将V2缓慢降低，直至 $V_{DO} = "L" \rightarrow$  脉冲 " $H$ " 时(此时放电过电流状态解除后，可能由于V2电压高于 $V_{SHORT}$ 而发生负载短路保护再次使 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ )的V2电压即为放电过电流状态的解除电压 ( $V_{RIOV}$ )。

### 4. 负载短路保护电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2瞬间提升，经过负载短路保护延迟时间 ( $T_{SHORT}$ )后立即发生 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ ，此时的V2的电压即为负载短路保护电压 ( $V_{SHORT}$ )。

### 5. 充电过流保护电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2降低，直至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止，此时的V2电压即为充电过电流保护电压 ( $V_{CHA}$ )。

### 6. 工作时消耗电流（测试电路 3）

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下，流经 VDD 端子的电流  $I_{CC}$  即为工作时消耗电流 ( $I_{OPC}$ )。

### 7. 过放电时消耗电流（测试电路 3）

在 V1=V2=1.5V 设置后的状态下，流经 VDD 端子的电流  $I_{CC}$  即为过放时消耗电流 ( $I_{OPED}$ )。

### 8. VDD 端子-VM 端子间电阻（测试电路 3）

在 V1=1.8V, V2=0V 设置后的状态下，VDD 端子-VM 端子间电阻即为  $R_{VMC}$ 。

### 9. VM 端子-VSS 端子间电阻（测试电路 3）

在 V1=3.5V, V2=1.0V 设置后的状态下，VM 端子-VSS 端子间电阻即为  $R_{VMS}$ 。

### 10. CO 端子电阻 “H”（测试电路 4）

在 V1=3.5V, V2=0V, V3=3.1V 设置后的状态下，VDD 端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "H" ( $R_{COH}$ )。

### 11. CO 端子电阻 “L”（测试电路 4）

在 V1=4.7V, V2=0V, V3=0.4V 设置后的状态下，VM 端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "L" ( $R_{COL}$ )。

### 12. DO 端子电阻 “H”（测试电路 4）

在 V1=3.5V, V2=0V, V4=3.1V 设置后的状态下，VDD 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "H" ( $R_{DOH}$ )。

**13. DO 端子电阻 "L" (测试电路 4)**

在 V1=1.8V, V2=0V, V4=0.4V 设置后的状态下, VSS 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "L" ( $R_{DOL}$ )。

**14. 过充电保护延迟时间 (测试电路 5)**

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下, 将 V1 提升, 从 V1 超过  $V_{OC}$  时开始到  $V_{CO} = "L"$  为止的时间即为过充电保护延迟时间 ( $T_{OCP}$ )。

**15. 过放电保护延迟时间 (测试电路 5)**

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下, 将 V1 降低, 从 V1 低于  $V_{OD}$  时开始到  $V_{DO} = "L"$  为止的时间即为过放电保护延迟时间 ( $T_{ODP}$ )。

**16. 放电过流保护延迟时间 (测试电路 5)**

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下, 将 V2 提升, 从 V2 超过  $V_{EC}$  时开始到  $V_{DO} = "L"$  为止的时间即为放电过流保护延迟时间 ( $T_{ECP}$ )。

**17. 负载短路保护延迟时间 (测试电路 5)**

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下, 将 V2 提升, 从 V2 超过  $V_{SHORT}$  时开始到  $V_{DO} = "L"$  为止的时间即为负载短路保护延迟时间 ( $T_{SHTP}$ )。

**18. 充电过流保护延迟时间 (测试电路 5)**

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下, 将 V2 降低, 从 V2 低于  $V_{CHA}$  时开始到  $V_{CO} = "L"$  为止的时间即为充电过流保护延迟时间 ( $T_{CHP}$ )。

**19. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电的功能) (测试电路 2)**

在 V1=V2=0V 设置后的状态下, 将 V2 缓慢降低, 当  $V_{CO} = "H"$  ( $V_{CO} = VDD$ ) 时的 V2 的电压的绝对值即为允许向 0V 电池充电的充电器电压 ( $V_{0CHA}$ )。

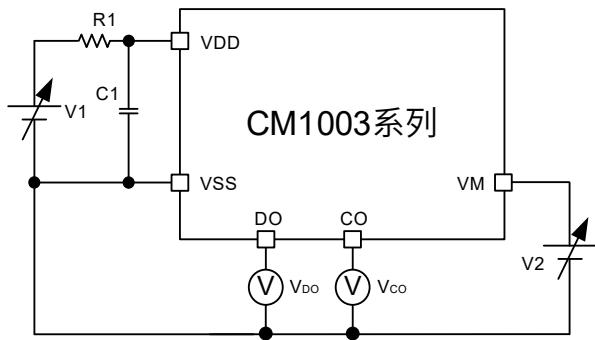


图 7 测试电路 1

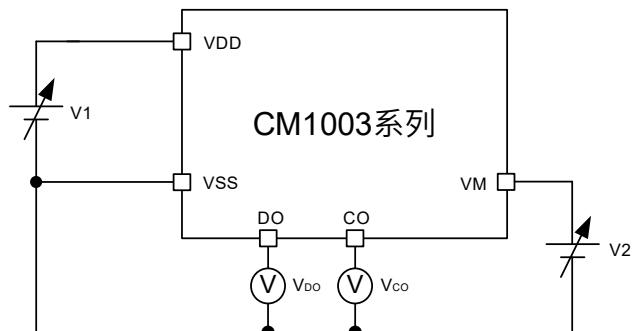


图 8 测试电路 2

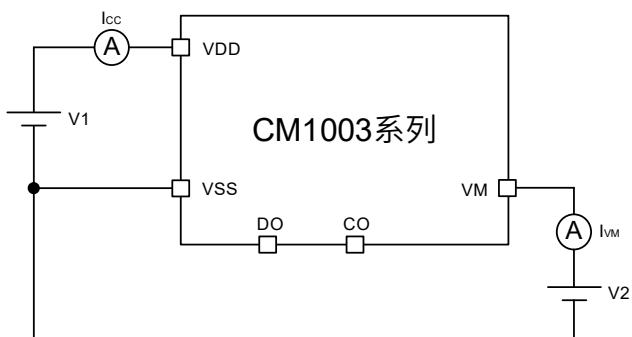


图 9 测试电路 3

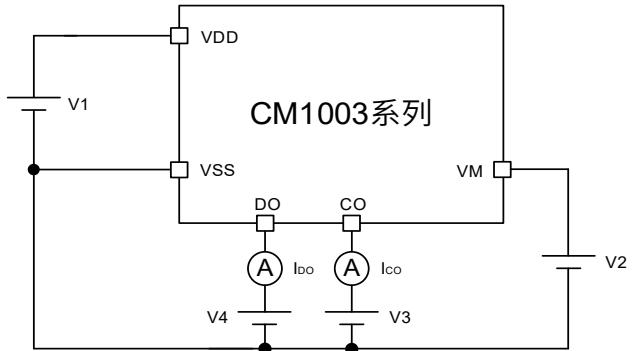


图 10 测试电路 4

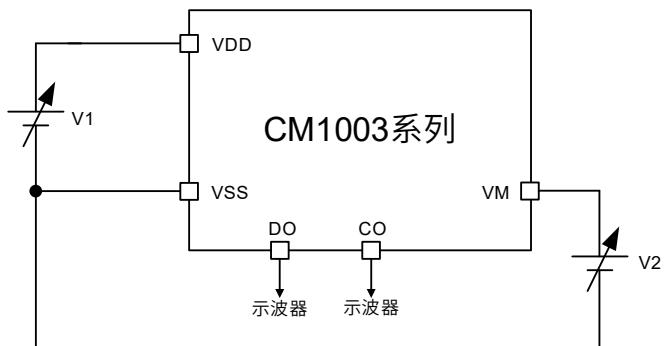


图 11 测试电路 5

■ 封装信息

SOT23-6

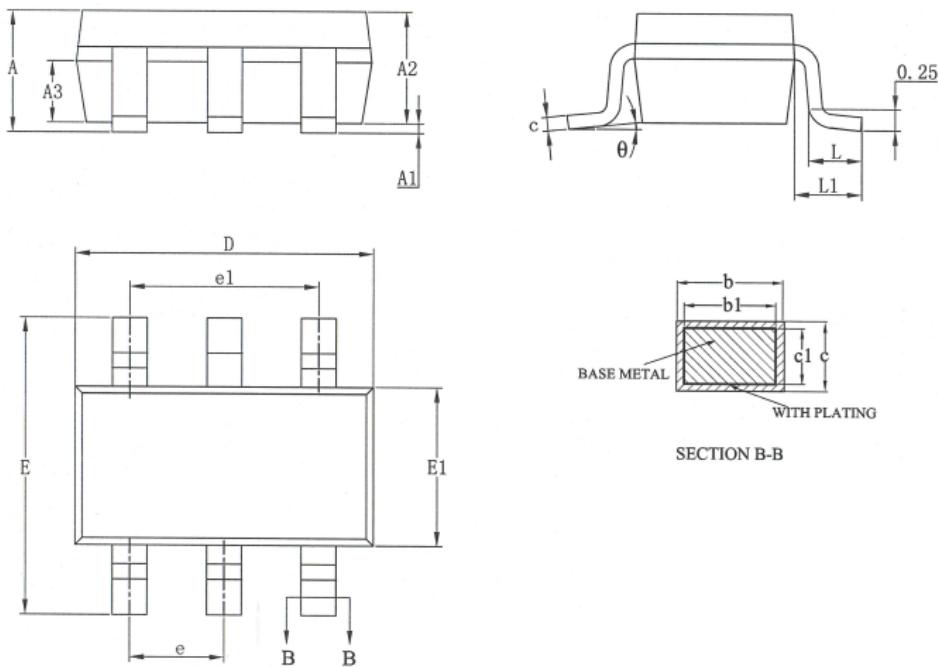


图 12

单位: mm

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
<b>A</b>	-	-	1.45
<b>A1</b>	0	-	0.15
<b>A2</b>	0.90	1.15	1.30
<b>A3</b>	0.60	0.65	0.70
<b>b</b>	0.39	-	0.49
<b>b1</b>	0.35	0.40	0.45
<b>c</b>	0.08	-	0.22
<b>c1</b>	0.08	0.13	0.20
<b>D</b>	2.70	2.90	3.10
<b>E</b>	2.60	2.80	3.00
<b>E1</b>	1.40	1.60	1.80
<b>e</b>	0.85	0.95	1.05
<b>e1</b>	1.80	1.90	2.00
<b>L</b>	0.35	0.45	0.60
<b>L1</b>	0.35	0.60	0.85
<b>θ</b>	0°	-	8°

表 9

■ 载带信息

SOT23-6

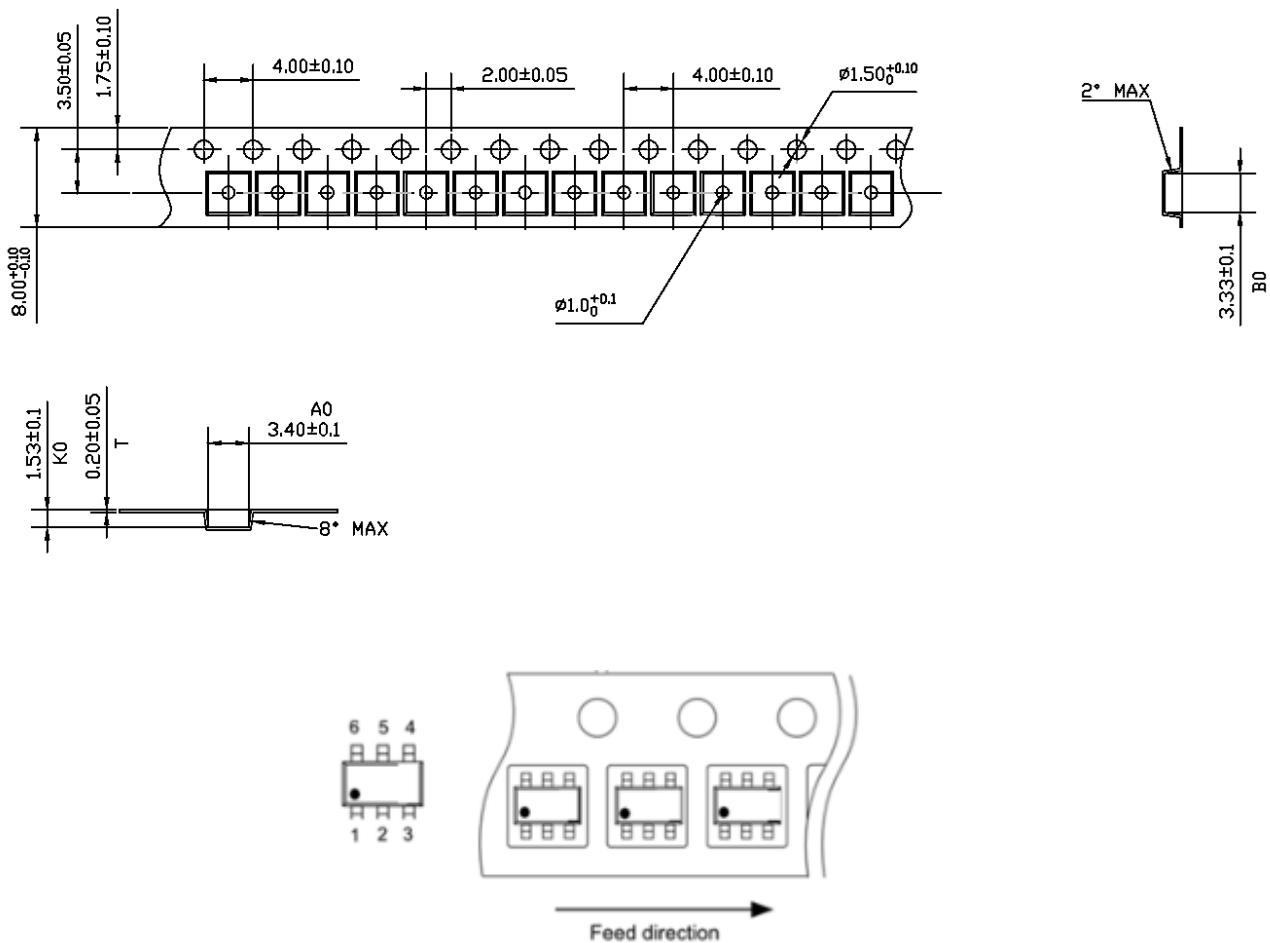


图 13

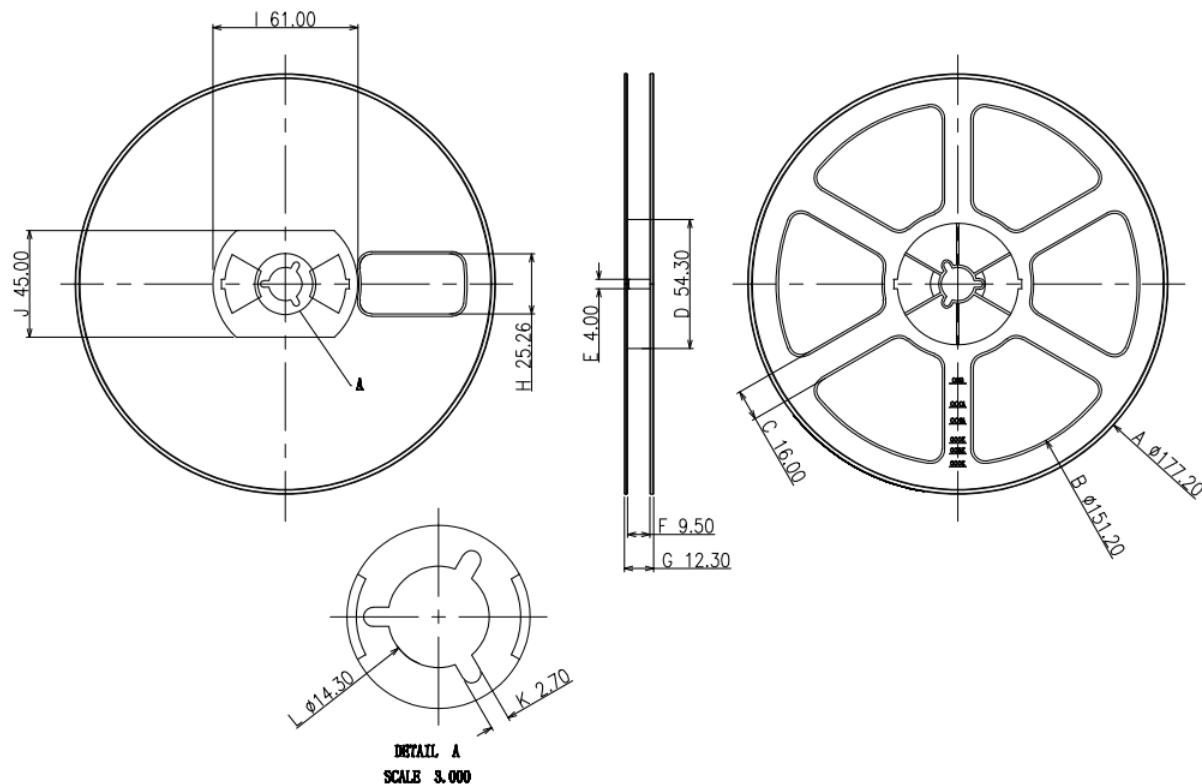
**■ 卷盘信息**

图 14

**■ 包装信息**

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

## 使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。  
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。